



Toshiba Memory Europe lance une mémoire de classe stockage, la XL-FLASH

La NAND la plus performante sur le marché est aussi une solution économique pour réduire la latence

Düsseldorf, Allemagne, 5 août 2019 - Toshiba Memory Europe (TME) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle mémoire SCM (Storage Class Memory, ou mémoire de classe stockage) : la XL-FLASH™. Basée sur la technologie innovante de mémoire Flash 3D BiCS FLASH™ à cellules SLC (Single Level Cell, ou cellule simple niveau) à 1 bit par cellule de la société, la XL-FLASH garantit une faible latence et des performances élevées aux centres de données et au stockage d'entreprise.

Classé comme SCM (ou mémoire persistante), avec la capacité de conserver son contenu comme une mémoire Flash NAND, la XL-FLASH comble l'écart de performance existant entre DRAM et NAND. Si les mémoires volatiles comme la DRAM offrent la vitesse d'accès nécessaire aux applications les plus exigeantes, cette performance a un coût élevé. Alors que le coût par bit et l'évolutivité des DRAM se stabilisent, cette nouvelle couche SCM au sein de la hiérarchie mémoire s'attaque au problème, avec une solution mémoire Flash NAND non-volatile, haute-densité et économique. Alors que le marché des mémoires SCM est en croissance, le cabinet d'analyse IDC estime qu'il va dépasser 3 milliards de dollars en 2022^[1].

Entre la DRAM et la Flash NAND, la XL-FLASH apporte un gain de vitesse, une latence réduite et des capacités de stockage supérieures, le tout à un coût inférieur à celui des DRAM traditionnelles. La XL-FLASH sera initialement déployée dans des disques SSD, mais pourrait être étendue à d'autres dispositifs connectés aux canaux mémoire par l'intermédiaire du bus DRAM, comme les futurs modules mémoire NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module).

Principales caractéristiques

- **Puce 128 Gbits** (en boîtiers de 2, 4 ou 8 puces)
- **Taille de page 4 Ko** pour des lectures et écritures du système d'exploitation plus efficaces
- **Architecture à 16 plans** pour un parallélisme plus efficace
- **Lecture et écriture de page rapides** La XL-FLASH offre une faible latence de lecture (inférieure à 5 microsecondes), ce qui est environ 10 fois plus rapide que la Flash TLC existante^[2]

En tant qu'inventeur de la Flash NAND, en tant que première entreprise à avoir lancé la mémoire Flash 3D, et en tant que leader de la migration de processus, Toshiba Memory est en position idéale pour fournir de la mémoire SCM à base SLC produite grâce à un processus de fabrication mature, une évolutivité éprouvée et une fiabilité SLC à l'épreuve du temps.

« La XL-FLASH est la NAND la plus performante du marché, grâce à l'utilisation de notre BiCS FLASH en mode SLC, » a déclaré Axel Stoermann, Vice-Président de Toshiba Memory Europe. « En ne stockant qu'un bit par cellule, nous sommes en mesure d'augmenter considérablement les performances. Et comme la XL-FLASH s'appuie sur des technologies éprouvées déjà produites en série, nos clients vont pouvoir réduire leur "time-to-market" (délai de commercialisation) en adoptant la XL-FLASH comme mémoire de classe stockage. »

Les premiers échantillons seront livrés en septembre 2019, et la production en série devrait démarrer en 2020.

Notes :

[1] IDC mai 2019 - Prévisions mondiales pour les disques SSD , 2019-2023, Doc # US43828819

[2] Par rapport à la NAND TLC de TMC, dont la latence de lecture est d'environ 50 microsecondes.

La revendication de NAND la plus performante du marché s'appuie sur le fait que la puce a été spécialement conçue (16 plans) pour fournir des performances supérieures à celles de la NAND TLC.

Tous les noms de société, de produit, et de service peuvent être des marques commerciales de leurs entreprises

respectives.

Pour chaque mention d'un produit Toshiba Memory La densité du produit est identifiée en fonction de la densité de la ou des puces mémoire du produit, et non en fonction de la capacité mémoire disponible pour le stockage des données par l'utilisateur final. La capacité utilisable par l'utilisateur est moindre, du fait de zones de données supplémentaires, du formatage, d'éventuels blocs défectueux, et d'autres contraintes, et peut également varier selon le dispositif hôte et l'application. Pour plus de détails, merci de vous reporter aux spécifications produit applicables. La définition de 1 Gbits = 2^{30} bits = 1.073.741.824 bits La définition de 1 Go = 2^{30} octets = 1.073.741.824 octets La définition de 1 Ko = 2^{10} octets = 1.024 octets

###

A propos de Toshiba Memory Europe

Toshiba Memory Europe est la branche européenne de Toshiba Memory Corporation. La société propose une large gamme de mémoires flash haut-de-gamme, notamment des cartes SD, des clés USB, et des composants mémoire embarqués, en plus de disques SSD (Solid State Disk, ou disque à semi-conducteurs). Notre société dispose de bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Le président de la société est Masaru Takeuchi.

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de mémoires et produits SSD, merci de visiter business.toshiba-memory.com

Contact pour publication :

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 368 77-0 Fax : +49 (0) 211 368 774 00

E-mail : support@toshiba-memory.com

Contact Presse :

Sandrine Aubert, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 579

E-mail: SAubert@toshiba-tme.eu

Issued by:

Birgit Schöninger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

Réf : TME035A_FRE